

Micron 的混合式記憶體立方被 EE Times（電子工程專輯）和 EDN（電子設計新聞）

提名為 年度記憶體產品

愛達荷州博伊西，2013年4月26日（GLOBE NEWSWIRE）-- Micron Technology, Inc.（納斯達克股票代碼：MU）今日宣佈其混合式記憶體立方被行業專家小組提名為年度記憶體產品。

由 EE Times 和 EDN 于本周在 Design West 舉辦的 ACE（先進電腦環境）頒獎活動上頒發了該獎項，該技術年會面向電子設計工程師、企業家和專業技術人員。隨著各種應用的系統設計師對新型記憶體系統設計在頻寬、密度和能源利用率方面的需求不斷增長，此次年度大獎標誌著業內一個關鍵時刻的到來。長期以來，在 DRAM 的性能提升率與處理器的資料消費率之間一直存在著缺口，這種困境被稱為“記憶體壁壘”。而混合式記憶體立方（HMC）已被視為走出該困境的首要並且有巨大影響力的解決方案。

“電子設計新聞和 EETimes(電子工程專輯)是對設計工程師和系統架構師最優影響力和深度的刊物”，Micron DRAM 解決方案集團副總裁 Brian Shirley 說到。“就混合式記憶體立方對電子行業前所未有的影響力方面能與他們達成共識，我們深感榮幸”。

HMC 是業內的一次突破，採用了先進的直通矽晶穿孔技術（TSV），該技術使用垂直管道電子化連接獨立晶片堆疊，並結合 Micron 最先進的 DRAM 晶片與高性能的邏輯。HMC 在頻寬和效率上大大超越了當前的設備能力，資料傳輸能力比 DDR3 暴增 15 倍，與現有技術相比，其能耗不到 70%，體積只有 90%。Micron 預計將在今年晚些時候推出該技術革命的首款工程樣本。

## 關於 Micron

Micron Technology, Inc. 是全球領先的先進半導體解決方案供應商之一。通過它遍佈全球的運營，Micron 為先進的計算、使用者、網路、嵌入式和移動產品生產和銷售全套 DRAM、NAND 和 NOR 快閃記憶體，以及其他創新的記憶體技術、封裝方案和半導體系統。Micron 的普通股在納斯

達克上市交易，代碼是 MU。欲瞭解有關 Micron Technology, Inc.的更多資訊，請訪問 [www.micron.com](http://www.micron.com)。

(C)2013 Micron Technology, Inc.版權所有。資料若有修改恕不另行通知。Micron 和 Micron orbit 徽標是 Micron Technology, Inc.的商標或注冊商標。所有其他商標或服務標記分別為其各自所有者擁有。本新聞稿包含有關混合式記憶體立方的前瞻性陳述。實際情況或結果可能與前瞻性陳述中包括的內容不同。請參考 Micron 和證券交易委員會定期發佈的匯總檔，特別是 Micron 最新的 10-K 和 10-Q 表。這些檔包含並確定導致匯總檔中的內容與前瞻性陳述不同的重要因素（見“某些因素”）。儘管我們認為前瞻性陳述中所反映的預期是合理的，但我們不能保證其未來結果、活動程度、性能或成就。

聯繫方式：Micron Media Contact:

Scott Stevens

Micron Technology, Inc.

+1-512-288-4050

[sstevens@micron.com](mailto:sstevens@micron.com)